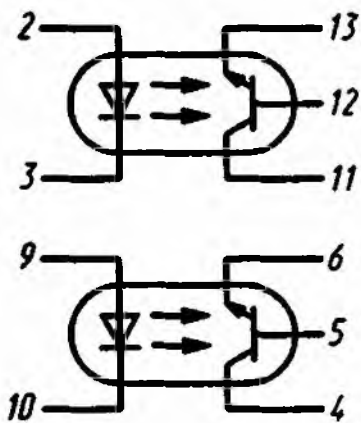


К249КП1, К249КП2

Оптоэлектронные ключи, состоящие из излучающего диода на основе соединения арсенид—галлий—алюминий и кремниевого фототранзистора. Предназначены для гальванической развязки узлов аппаратуры, между которыми передаются сигналы.

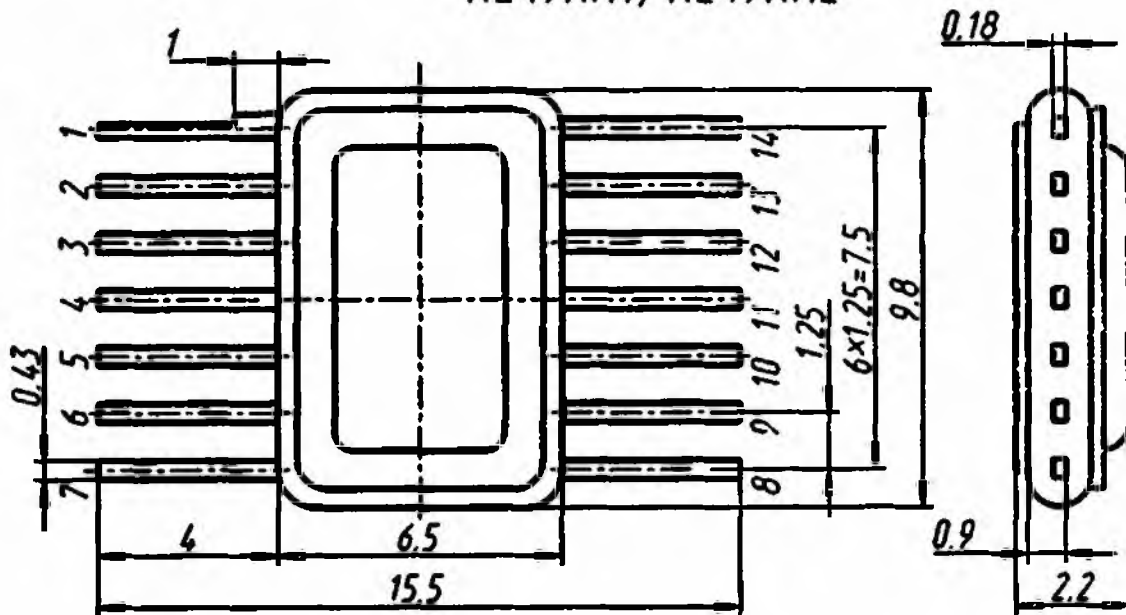


Прибор К249КП1 состоит из двух транзисторных оптопар. В приборе К249КП2 работоспособность второй оптопары не гарантируется или она отсутствует.

У приборов К249КП1 вывод 1 с ключом; у приборов К249КП2 вывод 1 обозначается точкой; отсчет выводов — против часовой стрелки.

Масса прибора не более 2 г.

К249КП1, К249КП2



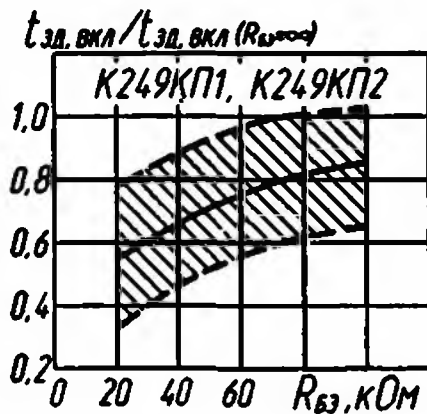
Электрические параметры

Выходное остаточное напряжение при $I_{вх} = 10 \text{ мА}$, $I_{ком} = 2 \text{ мА}$, не более	0,4 В
Ток утечки на выходе при $U_{ком} = 30 \text{ В}$, не более	100 мкА
Коэффициент передачи тока при $U_{ком} = 10 \text{ В}$, $I_{вх} = 10 \text{ мА}$, $R_{н} = 1,2 \text{ кОм}$, не менее	0,5%
Время задержки включения:	
при $R_{н} = 100 \text{ Ом}$, $U_{ком} = 10 \text{ В}$, $I_{вх} = 10 \text{ мА}$, не более	4 мкс

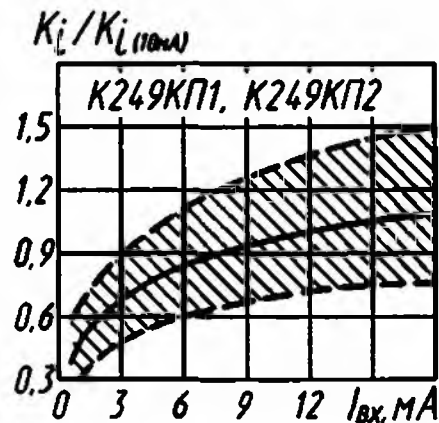
при $R_H = 1 \text{ кОм}$, $I_{\text{КОМ}} = 2 \text{ мА}$, $I_{\text{ВХ}} = 10 \text{ мА}$, не более	8 мкс
Время задержки выключения, не более:	
при $R_H = 100 \text{ Ом}$, $U_{\text{КОМ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{ВХ}} = 10 \text{ мА}$	4 мкс
при $R_H = 1000 \text{ Ом}$, $I_{\text{КОМ}} = 2 \text{ мА}$, $I_{\text{ВХ}} = 10 \text{ мА}$	25 мкс
Сопротивление изоляции при $U_{\text{ИЗ}} = 100 \text{ В}$, не менее	$5 \cdot 10^8 \text{ Ом}$

Предельные эксплуатационные данные

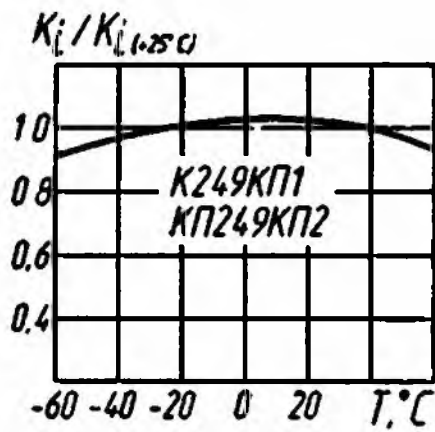
Коммутируемое напряжение на выходе	30 В
Обратное напряжение на входе	2,5 В
Напряжение изоляции	100 В
Постоянный коммутируемый ток на выходе ...	5 мА
Постоянный входной ток	10 мА
Импульсный входной ток:	
при $t_H \leq 10 \text{ мс}$, $Q = 2$	15 мА
при $t_H = 0,1 \text{ мс}$, $Q = 10$	10...20 мА
Рассеиваемая мощность транзистора	20 мВт
Рассеиваемая мощность всем прибором	34 мВт
Температура окружающей среды	-45...+55 °С



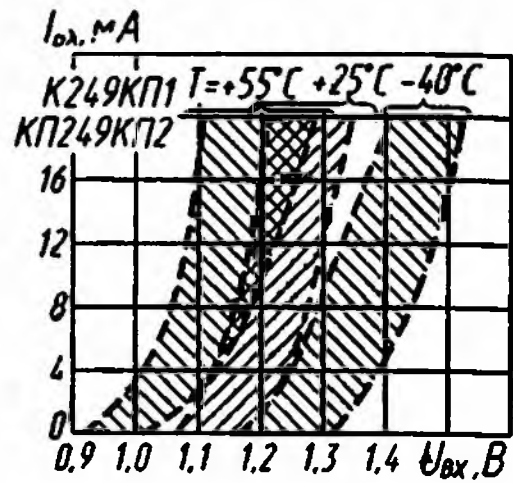
Зона возможных положений зависимости времени задержки включения от сопротивления база—эмиттер



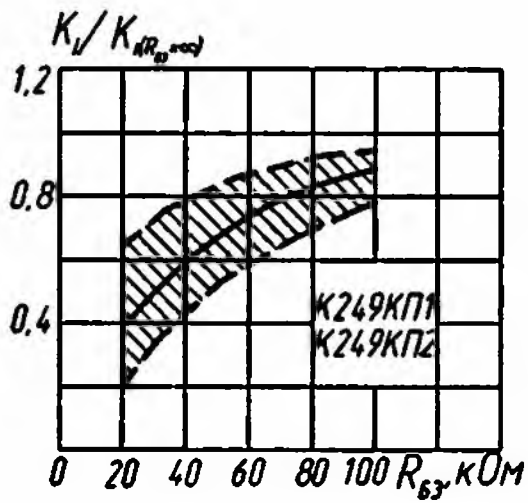
Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока от входного тока



Зависимость коэффициента передачи тока от температуры



Зоны возможных положений зависимости входного тока от входного напряжения



Зона возможных положений зависимости коэффициента передачи тока от сопротивления база—эмиттер